Відповіді, будь ласка, надрукуйте

(якщо не вистачає місця, надрукуйте на окремому аркуші)

Оліх	Олег	Ярославович
(Ім'я)	(по-батькові)	(Прізвище)
	01, місто Київ, вул. Володимирська, 64/1	_
		_
Домашня адреса: Україна, 0222 Телефон служб.: +38 (044) 521-	2, місто Київ, пр. Червоної Калини 32, кв	

Oleg	Yaroslavovych	Olikh
(First Name)	(Middle Name)	(Last Name)
NENT ADDRESS: <u>64/13, '</u>	Volodymyrska Street, City of Kyiv, Ukra	nine, 01601

Особисті дані

Освіта:

Учбовий заклад	місце розташування	спеціальність	Степінь	Рік закінчення
Київський університет ім. Тараса Шевченка, фізичний факультет	м. Київ, Україна	фізика твердого тіла	спеціаліст	1996
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантура	м. Київ, Україна	фізика твердого тіла	Кандидат фізико- математичних наук	2000

Нагороди та премії:

Премія імені І. Пулюя Національної академії наук України (2021)

Перелік найголовніших посад:

Організація	посада	обов'язки	термін
		(викл. наук. адм)	
Київський національний університет імені Тараса Шевченка	заступник декана фізичного факультету	викл., наук., адм	2007-2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка	професор кафедри загальної фізики	викл., наук.	2021

продовження на звороті

Перелік найголовніших публікацій (не більше 7):

- 1. Olikh O., Lytvyn P. «Defect engineering using microwave processing in SiC and GaAs», Semiconductor Science and Technology, 2022, vol.37, is.7, 075006
- 2. Olikh O., Kostylyov V., Vlasiuk V., Korkishko R., Chupryna R. «Intensification of iron–boron complex association in silicon solar cells under acoustic wave action», Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2022, vol.33, is.13, P. 13133-13142
- 3. Olikh O., Lozitsky O., Zavhorodnii O. «Estimation for iron contamination in Si solar cell by ideality factor: Deep neural network approach», Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 2022, vol.30, is.6, p. 648-660
- 4. Olikh O., Kostylyov V., Vlasiuk V., Korkishko R., Olikh Ya., Chupryna R. «Features of FeB pair light-induced dissociation and repair in silicon *n*+-*p*-*p*+ structures under ultrasound loading», Journal of Applied Physics, 2021, vol.130, is.23, 235703
- 5. Olikh O.Ya. «Relationship between the ideality factor and the iron concentration in silicon solar cells», Superlattices and Microstructures, 2019, vol.136, 106309
- 6. Olikh O.Ya. «Acoustically driven degradation in single crystalline silicon solar cell», Superlattices and Microstructures, 2018, vol.117, p. 173-188
- 7. Olikh O.Ya. «Non-Monotonic γ-Ray Influence on Mo/n-Si Schottky Barrier Structure Properties», IEEE Transactions on Nuclear Science, 2013, vol.60, is.1, part 2, p.394-40

Участь в інших професійних товариствах:

відсутня			

Дата народження та інші біографічні відомості:

Народився 5 червня 1974 р. у місті Києві. Одружений, маю доньку.

Julks

У 2018 р. захистив дисертацію «Акусто- та радіаційно-індуковані явища в поверхнево-бар'єрних кремнієвих та арсенід-галієвих структурах» на здобуття наукового ступеню доктора фізико-математичних наук за спеціальністю фізика твердого тіла (диплом ДД №008094, 18.12.2018).

У 2022 р. присвоєно вчене звання професора кафедри загальної фізики (атестат АП №004651, 23.12.2022).

Особистий підпис

Дата <u>28 червня 2023 р.</u>

Рекомендації

(потрібно дві рекомендації членів УФТ):

Прізвищ	:	Підпис:	
Адреса:			
 Членськи	й квиток №		
Прізвищ	»:	Підпис:	
Адреса:			
Членськи	й квиток №		

До уваги: вступна процедура буде прискорена, якщо заповнені всі позиції.